

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成 27 年 7 月 9 日 (2015.7.9)

【公開番号】特開 2014-167987 (P2014-167987A)  
【公開日】平成 26 年 9 月 11 日 (2014.9.11)  
【年通号数】公開・登録公報 2014-049  
【出願番号】特願 2013-39377 (P2013-39377)  
【国際特許分類】

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 23/12 5 0 1 P

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 5 月 22 日 (2015.5.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

機能素子が形成された半導体基板と、  
前記機能素子と導通している金属膜と、  
絶縁樹脂層および前記絶縁樹脂層内に形成された配線電極を含む再配線層と、  
を備え、  
前記配線電極は、  
平面視で一部が前記金属膜と重なるように前記半導体基板の面方向に沿って形成された  
第 1 配線電極と、  
前記第 1 配線電極と対向し、前記再配線層の厚み方向で前記半導体基板と反対側に形成  
された第 2 配線電極と、  
前記金属膜および前記第 1 配線電極を導通させる第 1 層間接続導体と、  
平面視で前記第 1 層間接続導体から離れた位置で、前記第 1 配線電極および前記第 2 配  
線電極を導通させる第 2 層間接続導体と、  
を有する、半導体装置。